Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Б1.В.01.Д | В.02.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ | |
|---------------------|---|--|
| Физическа | я химия материалов электронной техники | |
| наименование | дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом | |
| Направление подгото | вки / специальность | |
| | 04.04.01 Химия | |
| Направленность (про | филь) | |
| | 04.04.01.07 Физическая химия | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Форма обучения | очная | |
| Год набора | 2023 | |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЛИСШИПЛИНЫ (МОЛУЛЯ)

| Программу составили |
|---------------------------------------|
| д-р хим наук, профессор, Денисов В.М. |
| должность инициалы фамилия |

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Основная цель изучения дисциплины - формирование фундаментальных знаний в области физико-химических процессов разработки материалов электронной техники и их применение для решения практических задач в области технологии их получения.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- освоение основных принципов контроля структуры и свойств полупроводниковых материалов;
- формирование представлений о методах выращивания монокристаллов полупроводниковых материалов;
- изучение основ получения чистых металлов и полупроводниковых материалов;
- изучение основ получения материалов с наперед заданными свойствами;
- установление основных принципов легирования полупроводниковых материалов;
- применение направленной кристаллизации при физико химическом анализе.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| 1 1 | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Запланированные результаты обучения по дисциплине | | | | | | | |
| ПК-2: Способен проводить пат | тентно-информационные исследования в | | | | | | | |
| выбранной области химии и / или смежных наук | | | | | | | | |
| ПК-2.1: Проводит поиск | знать российские и зарубежные патентно- | | | | | | | |
| специализированной | информационные бвзы данных | | | | | | | |
| информации в патентно- | уметь проводить патентный поиск по заданной | | | | | | | |
| информационных базах | тематике | | | | | | | |
| данных | владеть навыкми поиска необходимой информации с | | | | | | | |
| | использованием патентных баз данных | | | | | | | |
| ПК-2.2: Анализирует и | знать правила обощения и анаиза результатов | | | | | | | |
| обобщает результаты | патентного поиска по заданной тематике | | | | | | | |
| патентного поиска по | уметь анализировать и обощать результаты | | | | | | | |
| тематике проекта в выбранной | патентного поиска | | | | | | | |
| области химии (химической | владеть навыком анализа и обощения патентного | | | | | | | |
| технологии) | поиска. проведенного по заданной тематике | | | | | | | |
| ПК-4: Способен выбирать обос | нованные подходы к синтезу и анализу свойств | | | | | | | |
| полифункциональных материалов с заданными физико-химическими | | | | | | | | |

свойствами

| ПК-4.1: Применяет знания о | знать свойства веществ, используемых для |
|--|---|
| химических свойствах | получения материалов электронной техники, для |
| веществ, при анализе | анализа соотношения "состав - физико-химические |
| соотношения «состав - физико | свойства" |
| -химические свойства» | уметь применять знания о свойствах материалов электронной техники для анализа "состава и их физико-химических свойств" владеть умением анализировать соотношение "состав -физико-химические свойства" в целях получения и применения материалов электронной техники |
| TIV 4 2. Dryposom recom | |
| ПК-4.3: Вырабатывает стратегию поиска прототипов материалов, | знать физико-химические свойства материалов с необходимыми эксплуатационными свойствами, используемых в качестве прототипов |
| полифункционального | уметь выбирать необходимые эксплуатационные |
| назначения с учетом | условия и ограничения материалов в соотнесении с |
| требований к их физико- | их физико-имическими свойствами для подбора |
| химическим и | прототипа |
| эксплуатационным свойствам | владеть стратегией поиска прототипов материалов с |
| и возможных ограничений | необходимыми эксплуатационными свойствами |
| ПК-4.7: Выбирает на | знать физико-химические свойства материалов |
| основании знаний о физико- | уметь подбирать условия термической или химико- |
| химических свойствах | термической обработки веществ (материалов) для |
| материалов способы | электронной техники |
| термической или химико- | владеть знаниями о физико-химических свойствах |
| термической обработки | материалов для проведения их термической или |
| | химико-термической обработки |
| ПК-5: Способен к поиску и ана | лизу научной информации по актуальным |
| | бобщению отечественного и зарубежного опыта |
| по тематике исследования | |
| ПК-5.1: Проводит поиск | знать специализированные базы данных |
| научной информации в | уметь проводить литературный поиск по заданной |
| специализированных базах | теме с использованием отечественных и зарубежных |
| данных | информационных систем |
| | владеть навыком поиска информации по заданной |
| | тематике |
| ПК-5.2: Анализирует | знать современные тенденции и перспективы |
| современные тенденции и | развития производств в области материалов |
| перспективы развития | электронной техники |
| производств в области | уметь анализировать перспективность развития в |
| материаловедения и | области производст МЭТ |
| технологии материалов. | владеть методами анализа литературных данных |

1.4 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины: Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

| Вид учебной работы | Всего, зачетных единиц (акад.час) | 1 |
|-------------------------------------|--|---|
| Контактная работа с преподавателем: | 1 (36) | |
| занятия лекционного типа | 0,5 (18) | |
| практические занятия | 0,5 (18) | |
| Самостоятельная работа обучающихся: | 2 (72) | |
| курсовое проектирование (КП) | Нет | |
| курсовая работа (КР) | Нет | |
| Промежуточная аттестация (Экзамен) | 1 (36) | |

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

| | | Контактная работа, ак. час. | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|--|
| № п/п | Молупи темы (разделы) лисциплины | | ятия онного ппа | Семина Практи | тия семин ры и/или ические ятия | Лабора работн | типа торные ы и/или тикумы | | ятельная ак. час. | |
| | | Всего | В том числе в ЭИОС | Всего | В том числе в ЭИОС | Всего | В том числе в ЭИОС | Всего | В том числе в ЭИОС | |
| 1. M | етоды получения чистых материалов | | | | | | | | | |
| | 1. Основные этапы развития электроники. Роль материалов в развитии элементной базы электронной техники. Повышение эффективности и надежности работы электронной аппаратуры, основные направления её миниатюризации. Структурные свойства материалов электронной техники. | 1 | | | | | | | | |
| | 2. Основные этапы развития электроники. Роль материалов в развитии элементной базы электронной техники. Повышение эффективности и надежности работы электронной аппаратуры, основные направления её миниатюризации. Структурные свойства материалов электронной техники. | | | 2 | | | | | | |

| | _ | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| 3. Общие свойства и особенности материалов электронной техники | | | | 2 | |
| 4. Общая классификация материалов по электрическим и магнитным свойствам. Виды химической связи. Особенности строения твёрдых тел. Монокристаллы и элементы структурной кристаллографии. | 1 | | | | |
| 5. Общая классификация материалов по электрическим и магнитным свойствам. Виды химической связи. Особенности строения твёрдых тел. Монокристаллы и элементы структурной кристаллографии. | | 2 | | | |
| 6. Химическая связь. Особенности строения твердых тел, влияние агрегатного состояния на электрические свойства материалов. Роль поверхностных явлений. | | | | 4 | |
| 7. Чистые металлы и материалы в современной технике. Чистота и свойства металлов. Значения чистых металлов и полупроводниковых материалов для развития новой техники. Характеристика процессов разделения и очистки. | 1 | | | | |
| 8. Способы выражения степени чистоты металлов и полупроводниковых материалов. Общая характеристика и классификация способов разделения и очистки. Химические методы очистки. | | | | 6 | |
| 9. Равновесие жидкость-жидкость. Экстракция. Физико- химическая сущность экстракции и ее значение для разделения и очистки. Закон распределения. Изотермическое равновесие в тройной жидкой системе. | 1 | | | | |

| 10. Равновесие жидкость-жидкость. Экстракция. Физико -химическая сущность экстракции и ее значение для разделения и очистки. Закон распределения. Изотермическое равновесие в тройной жидкой системе. | | 2 | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| 11. Взаимная растворимость двух жидкостей. Механизм экстракции. Экстракция из растворов в трехкомпонентой системе. Равновесие ждкость-пар и твердое-пар. | | | | 4 | |
| 12. Дистилляция, сублимация и ректификация. Физико- химическая сущность сублимации и дистилляции. Кинетика сублимации и дистилляции. Удаление примесей путем испарения в вакууме. Применение ректификации для очистки и разделения металлов и соединений. | 1 | | | | |
| 13. Дистилляция, сублимация и ректификация. Физико- химическая сущность сублимации и дистилляции. Кинетика сублимации и дистилляции. Удаление примесей путем испарения в вакууме. Применение ректификации для очистки и разделения металлов и соединений. | | 2 | | | |
| Равновесие твердое-жидкость. Применимость уравнения Шредера ван Лаара. | | | | 4 | |
| 15. Кристаллизационные методы очистки. Методы исследования равновесия между твердой и жидкой фазами. Коэффициент распределения как параметр фазового равновесия и диаграммы состояния. Равновесная и неравновесная кристаллизация. | 1 | | | | |

| 16. Кристаллизационные методы очистки. Методы исследования равновесия между твердой и жидкой фазами. Коэффициент распределения как параметр фазового равновесия и диаграммы состояния. Равновесная и неравновесная кристаллизация. | | 4 | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 17. Виды направленной кристаллизации. | | | | 2 | |
| 18. Распределение компонентов при направленной кристаллизации. Нормальная направленная кристаллизация. Зонная перекристаллизация. Обычная зонная перекристаллизация. Зонное выравнивание. Неконсервативные процессы направленной кристаллизации. Коэффициент распределения. | 2 | | | | |
| 19. Распределение компонентов при направленной кристаллизации. Нормальная направленная кристаллизация. Зонная перекристаллизация. Обычная зонная перекристаллизация. Зонное выравнивание. Неконсервативные процессы направленной кристаллизации. Коэффициент распределения. | | | | | |
| 20. Расчет коэффициента распределения по экспериментальным данным направленной кристаллизации. Применение направленной кристаллизации при физико-химическом анализе. | | | | 4 | |
| 21. Зонная перекристаллизация градиентом температуры (ЗПГТ) полупроводниковых материалов. Физико-химические основы ЗПГТ. Кинетика зонной перекристаллизации градиентом температуры. Перераспределение примесей. | 2 | | | | |

| 22. Зонная перекристаллизация градиентом температуры (ЗПГТ) полупроводниковых материалов. Физико-химические основы ЗПГТ. Кинетика зонной перекристаллизации градиентом температуры. Перераспределение примесей. | | 2 | | | |
|---|---|---|--|----|--|
| 23. Применение ЗПГТ в полупроводниковой технологии. | | | | 8 | |
| 24. Методы выращивания монокристаллов. Вытягивание из расплава. Совершенные монокристаллы больших диаметров. Зонная плавка. Выращивание из паровой фазы. Выращивание из расплавов или растворов. Эпитаксиальное наращивание. Выращивание эпитаксиальных слоев осаждением в вакууме. Химическое осаждение из паровой фазы. Жидкостная эпитаксия. | 2 | | | | |
| 25. Основные этапы и требования к методам получения монокристаллов. Преимущества и недостатки каждого из метода. Получение профилированных материалов. Профилированные полупроводниковые материалы. Методы профилирования. Поликристаллические и аморфные полупроводники. Подготовка к контрольной работе. | | | | 10 | |
| 2. Технология получения материалов электронной техники | _ | _ | | | |
| 1. Технология элементарных полупроводников. Химические и физические свойства германия и кремния. Химические методы получения германия и кремния. Поведение примесей. Получение кристаллов германия и кремния высокой чистоты, получение п/п кристаллов с заданными свойствами. | 2 | | | | |

| 2. Технология элементарных полупроводников. Химические и физические свойства германия и кремния. Химические методы получения германия и кремния. Поведение примесей. Получение кристаллов германия и кремния высокой чистоты, получение п/п кристаллов с заданными свойствами. | | 2 | | | |
|--|---|---|--|----|--|
| 3. Получения германия и кремния выской чистоты. Подготовка реферата. | | | | 10 | |
| 4. Природа полупроводниковых соединений. Основные физико-химические свойства полупроводниковых соединений. Получение неразлагающихся полупроводниковых соединений. Антимониды индия и галлия. Полупроовдниковые термоэлектрические материалы. Твердые растворы неразлагающихся полупроводниковых соединений. | 2 | | | | |
| 5. Природа полупроводниковых соединений. Основные физико-химические свойства полупроводниковых соединений. Получение неразлагающихся полупроводниковых соединений. Антимониды индия и галлия. Полупроовдниковые термоэлектрические материалы. Твердые растворы неразлагающихся полупроводниковых соединений. | | 2 | | | |
| 6. Технология полупроводниковых соединений, методы получения. Подготовка реферата | | | | 10 | |

| 7. Технология и аппаратура для получения разлагающихся полупроводниковых соединений. Оксиды меди, цинка, кадмия и других металлов. Карбид кремния. Арсениды индия и галлия. Фосфориды индия и галлия. Полупроводниковые соединения AIIBVI. Твердые растворы разлагающихся полупроводниковых соединений. | 2 | | | | |
|---|----|----|--|----|--|
| 8. Получение разлагающихся полупроводниковых соединений. Виды обработки, контроль структуры и свойств полупроводниковых материалов. Виды обработки. Резка. Шлифовка. Полировка. Контроль структуры кристаллов. Контроль электрических параметров. Подготовка к экзамену. | | | | 8 | |
| 9. | | | | | |
| Всего | 18 | 18 | | 72 | |

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

- 1. Герасименко Н. Н., Пархоменко Ю. Н. Кремний материал наноэлектроники: учеб. пособие для студентов вузов(Москва: Техносфера).
- 2. Подкопаев О. И., Шиманский А. Ф. Выращивание монокристаллов германия с низким содержанием дислокаций и примесей: монография (Красноярск: СФУ).
- 3. Денисов В. М., Истомин С. А., Подкопаев О. И., Серебрякова Л. И., Антонова Л. Т., Пастухов Э. А., Белецкий В. В. Кремний и его сплавы: монография(Екатеринбург: УрО РАН).
- 4. Денисов В. М., Истомин С. А., Подкопаев О. И., Белоусова Н. В., Пастухов Э. А. Германий, его соединения и сплавы(Екатеринбург: УрО РАН).
- 5. Юзова В.А., Шелованова Г.Н., Комогорцев С.В., Патрушева Т.Н., Левицкий А.А., Зеер Г.М. Материалы и элементы электронной техники: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины(Красноярск: ИПК СФУ).
- 6. Денисова Л. Т., Денисов В. М. Избранные главы физической химии. Фазовые равновесия: учеб.-метод. пособие [для студентов спец. 020100.62 «Химия», 020101.65 «Химия», 020201.65 «Фундаментальная и прикладная химия»](Красноярск: СФУ).
- 7. Ищенко А. А., Фетисов Г. В., Асланов Л. А. Нанокремний: свойства, получение, методы исследования и контроля: [монография](Москва: ФИЗМАТЛИТ).
- 8. Бахвалов С. Г., Денисов В. М., Бахвалова И. П., Бахвалова И. П. Материалы электронной техники. Получение и свойства: сборник научных трудов НИИЦ "Кристалл" (Красноярск: КрасГУ).
- 9. Горелик С. С., Дашевский М. Я. Материаловедение полупроводников и диэлектриков: учебник(Москва: МИСИС).
- 10. Юзова В. А. Материалы и элементы электронной техники: учеб.-метод. пособие по самостоят. работе(Красноярск: СФУ).
- 11. Денисова Л. Т., Денисов В. М. Высокотемпературная физическая химия. Методы выращивания кристаллов: учеб.-метод. пособие [для студентов спец. 020100.68 Химия, 020101.65 Химия, 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия](Красноярск: СФУ).
- 12. Денисова Л. Т., Чумилина Л. Г., Денисов В. М. Высокотемпературная физическая химия. Методы выращивания кристаллов: учебнометодическое пособие(Красноярск: СФУ).
- 4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое университет имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

1. Сопровождение учебного процесса требует применения программного обеспечения, позволяющего создавать, редактировать,представлять текстовый и иллюстративный материал: MSOffice (MSWord, MSExcel, MSPowerPoint).

4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- 1. Научная Электронная Библиотека e-LIBRARY.RU. Полнотекстовая коллекция «Российские академические журналы on-line» (издательство «Наука») включает 139 журналов. Режим доступа: http://elibrary.ru/.
- 2. Royal Society of Chemistry журналы открытого доступа. Режим доступа: http://pubs.rsc.org.
- 3. Elsevier доступ к Freedom Collection издательства Elsevier. Режим доступа: http://www.sciencedirect.com
- 4. Электронная химическая энциклопедия он-лайн. -Режим доступа: http://www.xumuk.ru/encyklopedia

5 Фонд оценочных средств

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

6 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Технические средства обучения для проведения лекционных и занятий (мультимедийный проектор, интерактивная доска, ПЭВМ).